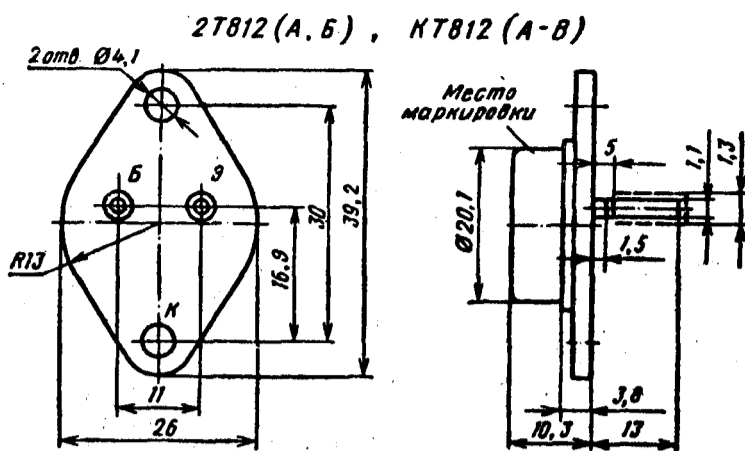


## 2Т812 (А, Б), КТ812 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Масса транзистора не более 20 г.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

$T_n = +25^\circ\text{C}$ :		
$U_{кв} = 3\text{ В}$ , $I_k = 8\text{ А}$ 2Т812А, 2Т812Б		5...15*...30*
$U_{кв} = 2,5\text{ В}$ , $I_k = 8\text{ А}$ КТ812А, КТ812Б, не менее		4
$U_{кв} = 5\text{ В}$ , $I_k = 5\text{ А}$ КТ812В		10...80*...125*
$T_n = +125^\circ\text{C}$ , $U_{кв} = 3\text{ В}$ , $I_k = 5\text{ А}$ 2Т812А, 2Т812Б, не менее		4
$T_n = -60^\circ\text{C}$ , $U_{кв} = 3\text{ В}$ , $I_k = 8\text{ А}$ 2Т812А, 2Т812Б, не менее		3
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кв} = 10\text{ В}$ , $I_k = 0,2\text{ А}$ , $f = 1\text{ МГц}$		3,5...6,5*...8,4*
Критическое напряжение при $I_k = 0,1\text{ А}$ , $I_{к,нас} = 100\text{ мА}$ , $L = 40\text{ мГн}$		350...450*...650* В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k = 8\text{ А}$ , $I_B = 1,6\text{ А}$		1*...1,35*...2,5 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k = 8\text{ А}$ , $I_B = 1,6\text{ А}$		1,8*...2,2*...2,5 В

Время спада при  $U_{кв} = 250\text{ В}$ ,  $U_{вв} = 4\text{ В}$ ,  $I_k = 5\text{ А}$ ,  $I_B = 2,5\text{ А}$  . . . . . 0,22...0,6\*...1,3 мкс

Обратный ток коллектора, не более:

$T_n = +25^\circ\text{C}$ , $U_{кв} = 700\text{ В}$ 2Т812А, КТ812А, $U_{кв} = 500\text{ В}$ 2Т812Б, КТ812Б, $U_{кв} = 300\text{ В}$ КТ812В		5 мА
типовое значение		
$T_n = +125^\circ\text{C}$ , $U_{кв} = 400\text{ В}$ 2Т812А, $U_{кв} = 300\text{ В}$ 2Т812Б		0,5* мА
$T_n = -60^\circ\text{C}$ , $U_{кв} = 500\text{ В}$ 2Т812А, $U_{кв} = 400\text{ В}$ 2Т812Б		10 мА

Обратный ток эмиттера не более:

$U_{вв} = 6\text{ В}$ 2Т812А, 2Т812Б		50 мА
типовое значение		5* мА
$U_{вв} = 7\text{ В}$ КТ812А, КТ812Б, КТ812В		150 мА

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кв} = 100\text{ В}$  . . . . . 70\*...85\*...100\* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер<sup>1</sup> при  $R_{сб} = 10\text{ Ом}$ ,  $t_u \leq 20\text{ мкс}$ ,  $t_{сб} \geq 3\text{ мкс}$ ,  $Q \geq 3$ ,  $T_n = -40...+85^\circ\text{C}$  2Т812А, 2Т812Б и  $t_u \leq 1\text{ мс}$ ,  $Q \geq 10$  или  $t_u \leq 50\text{ мкс}$ ,  $Q \geq 2$  КТ812А—2Т812В:

2Т812А, КТ812А	700 В
2Т812Б, КТ812Б	500 В
КТ812В	300 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер<sup>1</sup> при  $R_{сб} = 10\text{ Ом}$ ,  $t_u \leq 50\text{ мкс}$ ,  $t_{сб} \geq 0,3\text{ мкс}$ ,  $Q \geq 2$ ,  $T_n = -40...+85^\circ\text{C}$  . . . . . 350 В

Постоянное напряжение база — эмиттер:

2Т812А, 2Т812Б	6 В
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	7 В

Постоянный ток коллектора:

2Т812А, 2Т812Б	10 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	8 А

Импульсный ток коллектора:

2Т812А, 2Т812Б:	
$t_u \leq 20\text{ мкс}$ , $Q \geq 10$	17 А
$t_u \leq 20\text{ мкс}$ , $Q \geq 2$	12 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_u \leq 1\text{ мс}$ , $Q \geq 10$ или $t_u \leq 50\text{ мкс}$ , $Q \geq 2$	12 А

Постоянный ток базы:

2Т812А, 2Т812Б	4 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	3 А

Импульсный ток базы:

2Т812А, 2Т812Б:	
$t_u \leq 20\text{ мкс}$ , $Q \geq 10$	7 А
$t_u \leq 20\text{ мкс}$ , $Q \geq 2$	5 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_u \leq 1\text{ мс}$ , $Q \geq 10$ или $t_u \leq 50\text{ мкс}$ , $Q \geq 2$	4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>2</sup> 2Т812А, 2Т812Б при  $T_n = -60...+50^\circ\text{C}$  и КТ812А,

<sup>1</sup> При понижении температуры корпуса от  $-40$  до  $-60^\circ\text{C}$  и при повышении от  $+85$  до  $+100^\circ\text{C}$   $U_{кв,и,макс}$  линейно снижается до 500 В для 2Т812А и до 400 В для 2Т812Б; при повышении температуры корпуса от  $+100$  до  $+125^\circ\text{C}$   $U_{кв,и,макс}$  линейно снижается до 400 В для 2Т812А и до 300 В для 2Т812Б.

При  $t_{сб} \geq 0,3\text{ мкс}$  и понижении температуры корпуса от  $-40$  до  $-60^\circ\text{C}$  и при повышении температуры от  $+85$  до  $+125^\circ\text{C}$   $U_{кв,и,макс}$  линейно снижается до 300 В.

<sup>2</sup> При повышении температуры корпуса выше  $+80^\circ\text{C}$   $P_{к,макс}$  снижается в соответствии с формулой

$$P_{к,макс} = P_n - (T_n - T_{н-н}) R_{T(n-n)}$$

Значение  $R_{T(n-n)}$  определяется из области максимальных режимов.

КТ812Б, КТ812В при $T_n = -45...+50^\circ\text{C}$	50 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 <sup>o</sup> С
Температура окружающей среды:	
2Т812А, 2Т812Б	-60 <sup>o</sup> С... $T_n = +125^\circ\text{C}$
КТ812А, КТ812Б, КТ812В	-45 <sup>o</sup> С... $T_n = +85^\circ\text{C}$

При применении транзисторов в каскадах строчной развертки телевизоров допускается эксплуатация их с коэффициентом загрузки, равным единице по  $U_k$  и  $I_k$ ; при этом температура корпуса не должна превышать  $+100^\circ\text{C}$ .

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 5 мм, температура пайки не выше  $+250^\circ\text{C}$  в течение 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.